

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(43) 国际公布日
2022 年 5 月 12 日 (12.05.2022)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2022/095336 A1

(51) 国际专利分类号:

C23C 14/34 (2006.01) C22C 1/05 (2006.01)
C22C 27/06 (2006.01)

PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(21) 国际申请号: PCT/CN2021/086058

(22) 国际申请日: 2021 年 4 月 9 日 (09.04.2021)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

202011217394.8 2020 年 11 月 4 日 (04.11.2020) CN

(71) 申请人: 宁波江丰电子材料股份有限公司
(KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL CO.,
LTD) [CN/CN]; 中国浙江省余姚市名邦科技工业
园区安山路198号, Zhejiang 315400 (CN)。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(72) 发明人: 姚力军(YAO, Lijun); 中国浙江省余姚
市名邦科技工业园区安山路 198 号, Zhejiang
315400 (CN)。 边逸军(BIAN, Yijun); 中国浙江
省余姚市名邦科技工业园区安山路 198 号,
Zhejiang 315400 (CN)。 潘杰(PAN, Jie); 中国浙
江省余姚市名邦科技工业园区安山路 198 号,
Zhejiang 315400 (CN)。 王学泽(WANG, Xueze);
中国浙江省余姚市名邦科技工业园区安山
路198号, Zhejiang 315400 (CN)。 杨慧珍(YANG,
Huizhen); 中国浙江省余姚市名邦科技工业园
区安山路198号, Zhejiang 315400 (CN)。

(74) 代理人: 北京品源专利代理有限公司(BEYOND
ATTORNEYS AT LAW); 中国北京市海淀区莲花
池东路39号西金大厦6层, Beijing 100036 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家
保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,
CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT,
JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,

(54) Title: METHOD FOR PREPARING CHROMIUM-SILICON ALLOY SPUTTERING TARGET MATERIAL

(54) 发明名称: 一种铬硅合金溅射靶材的制备方法

(57) Abstract: Provided is a method for preparing a chromium-silicon alloy sputtering target material. The preparation method comprises the following steps: (1) mixing a chromium powder and a silicon powder under non-oxidizing atmosphere conditions to obtain a mixed powder; (2) filling a mold with same, and then subjecting the mixed powder filled in the mold to vacuum hot-pressing sintering; and (3) after the vacuum hot-pressing sintering is finished, furnace cooling same to obtain the chromium-silicon alloy sputtering target material.

(57) 摘要: 本文提供了一种铬硅合金溅射靶材的制备方法, 所述制备方法包括如下步骤: (1) 非氧化性气氛条件下混合铬粉与硅粉, 得到混合粉料; (2) 装模, 对装模后的混合粉料进行真空热压烧结; (3) 真空热压烧结结束后随炉冷却, 得到所述铬硅合金溅射靶材。



WO 2022/095336 A1